

证券代码：002156

证券简称：通富微电

公告编号：2010-033

南通富士通微电子股份有限公司 与富士通半导体株式会社 签署合作设立研发中心意向书的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

为深化公司与富士通半导体株式会社（以下简称“富士通半导体”）的合作，促进双方的科技创新和进步，公司与富士通半导体拟在合作、平等、共赢的基础上建立合作研发平台，利用半导体产业快速发展的机遇加快先进封装技术成果的转化及产业化。2010年8月30日，双方签署了《合作设立研发中心意向书》。

一、合作方与公司的关联关系

富士通半导体与公司第二大股东富士通（中国）有限公司同为富士通株式会社的全资子公司，同受富士通株式会社控制，为公司关联方。

二、《合作设立研发中心意向书》的主要内容

1. 研发中心设在公司，研发中心设主任一名，副主任两名。主任由公司董事长石明达担任，副主任分别由双方各推荐一名担任。富士通半导体委派3-4名研发人员在研发中心工作。富士通半导体委派人员的薪资待遇参照现行委派人员执行。

研发中心计划在2010年年内开始运行。

2. 双方共同协商制定研发中心的研发战略、方向及项目。在今后1-2年内，研发的重点是Fan-Out WLP、Low Cost FCBGA等技术。

3. 研发过程中形成的专利技术根据贡献度确定专利所有，双方均可使用该项专

利技术。

三、设立研发中心对公司的影响

研发中心的设立，将加大公司研发新型封装产品和技术的力度，有利于公司综合技术水平的提升，有利于加快先进封装技术成果的转化及产业化。同时，对公司优化产品结构，实现产品技术处于行业领先地位的目标也会产生实质性的积极作用。

四、风险提示

该意向书表达了双方的合作意向，具体合作事宜有待于双方进一步协商，并通过签署正式协议的方式确定。公司将根据合作进展情况，及时履行信息披露义务。

特此公告。

南通富士通微电子股份有限公司董事会

2010年8月31日